

Э Т И К Е Т К А

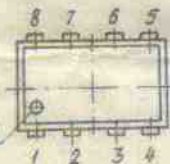
Микросхемы типа КР159НТ1А, КР159НТ1Б,
 КР159НТ1В, КР159НТ1Г, КР159НТ1Д, КР159НТ1Е
 соответствуют ГОСТ 18725-73 и техническим
 условиям 3.456.006 ТУ

БАЗОВАЯ СХЕМА ДИМЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Схема расположения выводов
 (нумерация выводов дана условно)

Таблица назначения
 выводов

Вывод	Назначение
2	Коллектор VT1
3	База VT1
4	Эмиттер VT1
5	Эмиттер VT2
6	База VT2
7	Коллектор VT2



Ключ

Масса не более 1,0 г.

Содержание драгоценных металлов
 в 1000 шт микросхем
 золото

0,2100МГ-Эл999,9

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Типовым	Норма	
			не менее	не более
Обратный ток коллектора, нА $U_{КБ} = 20 \text{ В}$	$I_{КБО}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	200
Обратный ток эмиттера, нА $U_{ЗБ} = 4 \text{ В}$	$I_{ЭБО}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	500
Ток утечки между транзисторами, нА $U_{Т1Т2} = 20 \text{ В}$	$I_{Т1Т2}$	KP159HT1A- KP159HT1E	-	20
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 5 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$	h_{213}^{**}	KP159HT1A, KP159HT1Г	20	80
		KP159HT1Б, KP159HT1Д	60	160
		KP159HT1В, KP159HT1Е	80	-
		KP159HT1А, KP159HT1Б	0,35*	-
Отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{КБ} = 2 \text{ В}, \tau_U = 2 \text{ мс}$ $I_3 = 1,0 \text{ мА}$ $I_3 = 0,05 \text{ мА}$	h_{2132}	KP159HT1Г, KP159HT1Д	0,75	-
		KP159HT1В, KP159HT1Е	0,35	-
		KP159HT1В, KP159HT1Е	0,75	-
		KP159HT1А- KP159HT1Е	2,0	-

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте
 $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 3,0 \text{ мА}, f = 10^6 \text{ Гц}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Типовым	Норма	
			не менее	не более
Модуль разности прямых амплитуд на переходах эмиттер-база, мВ $U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_3 = 1,0 \text{ мА}$	$U_{ЗБ1} - U_{ЗБ2}$	KP159HT1A, KP159HT1Б, KP159HT1Г, KP159HT1Д, KP159HT1Е	-	3
			-	15

Примечания: * За h_{2131} принимается значение параметра транзистора с меньшим коэффициентом передачи тока.

** Норма h_{213} задана для транзистора микроскопии с большим значением этого параметра.

*** Для изделий с ГСР $h_{213} / h_{2132} \geq 2,5$

ОТК

